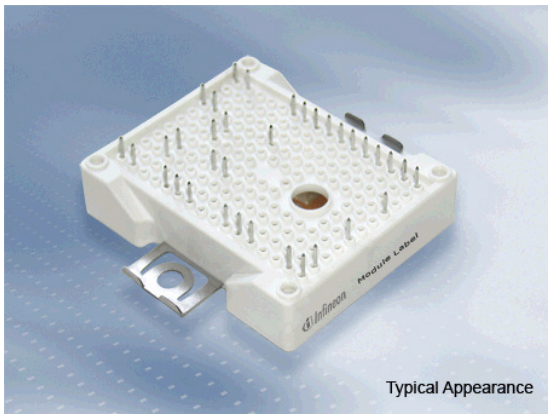
Technische Information / technical information

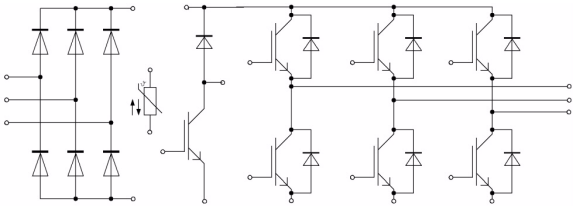
IGBT-Module
IGBT-modules

FP50R06W2E3

EasyPIM™ Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode und NTC
EasyPIM™ module with Trench/Fieldstop IGBT3 and Emitter Controlled 3 diode and NTC

Vorläufige Daten / preliminary data





V_{CES} = 600V
$I_{C\ nom}$ = 50A / I_{CRM} = 100A

Typische Anwendungen

- Hilfsumrichter
- Klimaanlagen
- Motorantriebe

Typical Applications

- Auxiliary Inverters
- Airconditions
- Motor Drives

Elektrische Eigenschaften

- Niedrige Schaltverluste
- Trench IGBT 3
- V_{CEsat} mit positivem Temperaturkoeffizienten
- niedriges V_{CEsat}

Electrical Features

- Low Switching Losses
- Trench IGBT 3
- V_{CEsat} with positive Temperature Coefficient
- Low V_{CEsat}

Mechanische Eigenschaften

- Al_2O_3 Substrat für kleinen thermischen Widerstand
- Kompaktes Design
- Lötverbindungs Technologie
- Robuste Montage durch integrierte Befestigungsklammern

Mechanical Features

- Al_2O_3 Substrate for Low Thermal Resistance
- Compact Design
- Solder Contact Technology
- Rugged mounting due to integrated mounting clamps

Module Label Code

Barcode Code 128

Sample
00000123456000000000000

DMX - Code

Content of the Code	Digit
Module Serial Number	1 - 5
Module Material Number	6 - 11
Production Order Number	12 - 19
Datecode (Production Year)	20 - 21
Datecode (Production Week)	22 - 23

prepared by: DK	date of publication: 2009-10-19	material no: 30418
approved by: MB	revision: 2.2	UL approved (E83335)

Vorläufige Daten
preliminary data

IGBT-Wechselrichter / IGBT-inverter

Höchstzulässige Werte / maximum rated values

Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage	T_{vj} = 25°C	V_{CES}	600	V
Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current	T_C = 75°C, T_{vj} = 175°C T_C = 25°C, T_{vj} = 175°C	$I_{C\ nom}$ I_C	50 65	A A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	t_P = 1 ms	I_{CRM}	100	A
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	T_C = 25°C, T_{vj} = 175°C	P_{tot}	175	W
Gate-Emitter-Spitzenspannung gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/-20	V

Charakteristische Werte / characteristic values

			min.	typ.	max.	
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage	I_C = 50 A, V_{GE} = 15 V I_C = 50 A, V_{GE} = 15 V I_C = 50 A, V_{GE} = 15 V	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	$V_{CE\ sat}$	1,45 1,60 1,70	1,90	V V V
Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage	I_C = 0,80 mA, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25°C		V_{GEth}	4,9	5,8	6,5	V
Gateladung gate charge	V_{GE} = -15 V ... +15 V		Q_G		0,50		µC
Interner Gatewiderstand internal gate resistor	T_{vj} = 25°C		R_{Gint}		0,0		Ω
Eingangskapazität input capacitance	f = 1 MHz, T_{vj} = 25°C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V		C_{ies}		3,10		nF
Rückwirkungskapazität reverse transfer capacitance	f = 1 MHz, T_{vj} = 25°C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V		C_{res}		0,095		nF
Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut-off current	V_{CE} = 600 V, V_{GE} = 0 V, T_{vj} = 25°C		I_{CES}			1,0	mA
Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current	V_{CE} = 0 V, V_{GE} = 20 V, T_{vj} = 25°C		I_{GES}			400	nA
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn-on delay time (inductive load)	I_C = 50 A, V_{CE} = 300 V V_{GE} = ±15 V R_{Gon} = 8,2 Ω	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	$t_{d\ on}$		0,025 0,025 0,025		µs µs µs
Anstiegszeit (induktive Last) rise time (inductive load)	I_C = 50 A, V_{CE} = 300 V V_{GE} = ±15 V R_{Gon} = 8,2 Ω	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	t_r		0,015 0,018 0,02		µs µs µs
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn-off delay time (inductive load)	I_C = 50 A, V_{CE} = 300 V V_{GE} = ±15 V R_{Goff} = 8,2 Ω	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	$t_{d\ off}$		0,19 0,21 0,215		µs µs µs
Fallzeit (induktive Last) fall time (inductive load)	I_C = 50 A, V_{CE} = 300 V V_{GE} = ±15 V R_{Goff} = 8,2 Ω	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	t_f		0,10 0,135 0,14		µs µs µs
Einschaltverlustenergie pro Puls turn-on energy loss per pulse	I_C = 50 A, V_{CE} = 300 V, L_S = 35 nH V_{GE} = ±15 V, di/dt = 2800 A/µs (T_{vj}=150°C) R_{Gon} = 8,2 Ω	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	E_{on}		0,55 0,75 0,85		mJ mJ mJ
Abschaltverlustenergie pro Puls turn-off energy loss per pulse	I_C = 50 A, V_{CE} = 300 V, L_S = 35 nH V_{GE} = ±15 V, du/dt = 4300 V/µs (T_{vj}=150°C) R_{Goff} = 8,2 Ω	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	E_{off}		1,20 1,50 1,60		mJ mJ mJ
Kurzschlussverhalten SC data	V_{GE} ≤ 15 V, V_{CC} = 360 V V_{CEmax} = V_{CES} -L_{sCE} ·di/dt	t_P ≤ 8 µs, T_{vj} = 25°C t_P ≤ 6 µs, T_{vj} = 150°C	I_{SC}		350 250		A A
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro IGBT / per IGBT		R_{thJC}		0,75	0,85	K/W
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro IGBT / per IGBT λ_{Paste} = 1 W/(m·K) / λ_{grease} = 1 W/(m·K)		R_{thCH}		0,70		K/W

Vorläufige Daten
preliminary data

Diode-Wechselrichter / diode-inverter

Höchstzulässige Werte / maximum rated values

Periodische Spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltage	T_{vj} = 25°C	V_{RRM}		600	V
Dauergleichstrom DC forward current		I_F		50	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forward current	t_P = 1 ms	I_{FRM}		100	A
Grenzlastintegral I²t - value	V_R = 0 V, t_P = 10 ms, T_{vj} = 125°C V_R = 0 V, t_P = 10 ms, T_{vj} = 150°C	I²t		370 330	A²s A²s

Charakteristische Werte / characteristic values

			min.	typ.	max.	
Durchlassspannung forward voltage	I_F = 50 A, V_{GE} = 0 V, T_{vj} = 25°C I_F = 50 A, V_{GE} = 0 V, T_{vj} = 125°C I_F = 50 A, V_{GE} = 0 V, T_{vj} = 150°C	V_F		1,55 1,50 1,45	1,95	V V V
Rückstromspitze peak reverse recovery current	I_F = 50 A, - di_F/dt = 2800 A/µs (T_{vj}=150°C), T_{vj} = 25°C V_R = 300 V, T_{vj} = 125°C V_{GE} = -15 V, T_{vj} = 150°C	I_{RM}		78,0 82,0 84,0		A A A
Sperrverzögerungsladung recovered charge	I_F = 50 A, - di_F/dt = 2800 A/µs (T_{vj}=150°C), T_{vj} = 25°C V_R = 300 V, T_{vj} = 125°C V_{GE} = -15 V, T_{vj} = 150°C	Q_r		2,25 4,00 4,40		µC µC µC
Abschaltenergie pro Puls reverse recovery energy	I_F = 50 A, - di_F/dt = 2800 A/µs (T_{vj}=150°C), T_{vj} = 25°C V_R = 300 V, T_{vj} = 125°C V_{GE} = -15 V, T_{vj} = 150°C	E_{rec}		0,58 1,00 1,10		mJ mJ mJ
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro Diode / per diode	R_{thJC}		1,10	1,20	K/W
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Diode / per diode λ_{Paste} = 1 W/(m·K) / λ_{grease} = 1 W/(m·K)	R_{thCH}		0,90		K/W

Diode-Gleichrichter / diode-rectifier

Höchstzulässige Werte / maximum rated values

Periodische Rückw. Spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltage	T_{vj} = 25°C	V_{RRM}		1600	V
Durchlassstrom Grenzeffektivwert pro Dio. forward current RMS maximum per diode	T_C = 100°C	I_{FRMSM}		60	A
Gleichrichter Ausgang Grenzeffektivstrom maximum RMS current at Rectifier output	T_C = 100°C	I_{RMSM}		60	A
Stoßstrom Grenzwert surge forward current	t_p = 10 ms, T_{vj} = 25°C t_p = 10 ms, T_{vj} = 150°C	I_{FSM}		450 370	A A
Grenzlastintegral I²t - value	t_p = 10 ms, T_{vj} = 25°C t_p = 10 ms, T_{vj} = 150°C	I²t		1000 685	A²s A²s

Charakteristische Werte / characteristic values

			min.	typ.	max.	
Durchlassspannung forward voltage	T_{vj} = 150°C, I_F = 50 A	V_F		1,05		V
Sperrstrom reverse current	T_{vj} = 150°C, V_R = 1600 V	I_R		1,00		mA
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro Diode per diode	R_{thJC}		1,05	1,15	K/W
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Diode / per diode λ_{Paste} = 1 W/(m·K) / λ_{grease} = 1 W/(m·K)	R_{thCH}		0,95		K/W

prepared by: DK	date of publication: 2009-10-19
approved by: MB	revision: 2.2

Vorläufige Daten
preliminary data

IGBT-Brems-Chopper / IGBT-brake-chopper

Höchstzulässige Werte / maximum rated values

Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage	T_{vj} = 25°C	V_{CES}	600	V
Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current	T_C = 75°C, T_{vj} = 175°C T_C = 25°C, T_{vj} = 175°C	I_{Cnom} I_C	50 65	A A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	t_P = 1 ms	I_{CRM}	100	A
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	T_C = 25°C, T_{vj} = 175°C	P_{tot}	175	W
Gate-Emitter-Spitzenspannung gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/-20	V

Charakteristische Werte / characteristic values

			min.	typ.	max.	
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage	I_C = 50 A, V_{GE} = 15 V I_C = 50 A, V_{GE} = 15 V I_C = 50 A, V_{GE} = 15 V	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	$V_{CE\ sat}$	1,45 1,60 1,70	1,90	V V V
Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage	I_C = 0,80 mA, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25°C		V_{GEth}	4,9	5,8	6,5	V
Gateladung gate charge	V_{GE} = -15 V ... +15 V		Q_G		0,50		µC
Interner Gatewiderstand internal gate resistor	T_{vj} = 25°C		R_{Gint}		0,00		Ω
Eingangskapazität input capacitance	f = 1 MHz, T_{vj} = 25°C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V		C_{ies}		3,10		nF
Rückwirkungskapazität reverse transfer capacitance	f = 1 MHz, T_{vj} = 25°C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V		C_{res}		0,095		nF
Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut-off current	V_{CE} = 600 V, V_{GE} = 0 V, T_{vj} = 25°C		I_{CES}			1,0	mA
Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current	V_{CE} = 0 V, V_{GE} = 20 V, T_{vj} = 25°C		I_{GES}			400	nA
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn-on delay time (inductive load)	I_C = 50 A, V_{CE} = 300 V V_{GE} = ±15 V R_{Gon} = 18 Ω	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	$t_{d\ on}$		0,045 0,045 0,045		µs µs µs
Anstiegszeit (induktive Last) rise time (inductive load)	I_C = 50 A, V_{CE} = 300 V V_{GE} = ±15 V R_{Gon} = 18 Ω	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	t_r		0,03 0,035 0,04		µs µs µs
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn-off delay time (inductive load)	I_C = 50 A, V_{CE} = 300 V V_{GE} = ±15 V R_{Goff} = 18 Ω	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	$t_{d\ off}$		0,31 0,32 0,33		µs µs µs
Fallzeit (induktive Last) fall time (inductive load)	I_C = 50 A, V_{CE} = 300 V V_{GE} = ±15 V R_{Goff} = 18 Ω	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	t_f		0,13 0,135 0,14		µs µs µs
Einschaltverlustenergie pro Puls turn-on energy loss per pulse	I_C = 50 A, V_{CE} = 300 V, L_S = 35 nH V_{GE} = ±15 V R_{Gon} = 18 Ω	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	E_{on}		1,50 2,00 2,10		mJ mJ mJ
Abschaltverlustenergie pro Puls turn-off energy loss per pulse	I_C = 50 A, V_{CE} = 300 V, L_S = 35 nH V_{GE} = ±15 V R_{Goff} = 18 Ω	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	E_{off}		1,20 1,50 1,60		mJ mJ mJ
Kurzschlussverhalten SC data	V_{GE} ≤ 15 V, V_{CC} = 360 V V_{CEmax} = V_{CES} -L_{sCE} · di/dt	t_P ≤ 8 µs, T_{vj} = 25°C t_P ≤ 6 µs, T_{vj} = 150°C	I_{SC}		350 250		A A
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro IGBT / per IGBT		R_{thJC}		0,75	0,85	K/W
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro IGBT / per IGBT λ_{Paste} = 1 W/(m·K) / λ_{grease} = 1 W/(m·K)		R_{thCH}		0,70		K/W

Vorläufige Daten
preliminary data

Diode-Brems-Chopper / Diode-brake-chopper

Höchstzulässige Werte / maximum rated values

Periodische Spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltage	T_{vj} = 25°C	V_{RRM}	600		V
Dauergleichstrom DC forward current		I_F	15		A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forw. current	t_p = 1 ms	I_{FRM}	30		A
Grenzlastintegral I²t - value	V_R = 0 V, t_P = 10 ms, T_{vj} = 125°C V_R = 0 V, t_P = 10 ms, T_{vj} = 150°C	I²t	22,5 20,5		A²s A²s

Charakteristische Werte / characteristic values

			min.	typ.	max.	
Durchlassspannung forward voltage	I_F = 15 A, V_{GE} = 0 V I_F = 15 A, V_{GE} = 0 V I_F = 15 A, V_{GE} = 0 V	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	V_F		1,60 1,55 1,50	2,00	V V V
Rückstromspitze peak reverse recovery current	I_F = 15 A, - di_F/dt = 1600 A/µs (T_{vj}=150°C) V_R = 300 V V_{GE} = -15 V	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	I_{RM}		23,0 25,0 26,0		A A A
Sperrverzögerungsladung recovered charge	I_F = 15 A, - di_F/dt = 1600 A/µs (T_{vj}=150°C) V_R = 300 V V_{GE} = -15 V	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	Q_r		0,80 1,40 1,70		µC µC µC
Abschaltenergie pro Puls reverse recovery energy	I_F = 15 A, - di_F/dt = 1600 A/µs (T_{vj}=150°C) V_R = 300 V V_{GE} = -15 V	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	E_{rec}		0,16 0,28 0,37		mJ mJ mJ
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro Diode / per diode		R_{thJC}		2,25	2,50	K/W
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Diode / per diode λ_{Paste} = 1 W/(m·K) / λ_{grease} = 1 W/(m·K)		R_{thCH}		1,40		K/W

NTC-Widerstand / NTC-thermistor

Charakteristische Werte / characteristic values

			min.	typ.	max.	
Nennwiderstand rated resistance	T_C = 25°C	R_{25}		5,00		kΩ
Abweichung von R_{100} deviation of R_{100}	T_C = 100°C, R_{100} = 493 Ω	ΔR/R	-5		5	%
Verlustleistung power dissipation	T_C = 25°C	P_{25}			20,0	mW
B-Wert B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298,15\ K))]$	$B_{25/50}$		3375		K
B-Wert B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/80}(1/T_2 - 1/(298,15\ K))]$	$B_{25/80}$		3411		K
B-Wert B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/100}(1/T_2 - 1/(298,15\ K))]$	$B_{25/100}$		3433		K

Angaben gemäß gültiger Application Note.
Specification according to the valid application note.

Vorläufige Daten
preliminary data

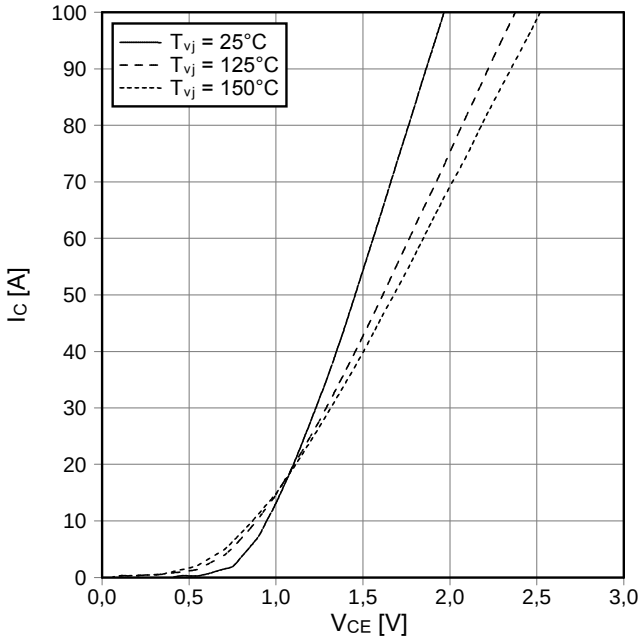
Modul / module

Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min.	V_{ISOL}		2,5		kV
Material für innere Isolation material for internal insulation				Al_2O_3		
Kriechstrecke creepage distance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal			11,5 6,3		mm
Luftstrecke clearance distance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal			10,0 5,0		mm
Vergleichszahl der Kriechwegbildung comparative tracking index		CTI		> 200		
			min.	typ.	max.	
Modulinduktivität stray inductance module		L_{sCE}		30		nH
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip module lead resistance, terminals - chip	T_C = 25°C, pro Schalter / per switch	$R_{CC'+EE'}$ $R_{AA'+CC'}$		5,00 6,00		mΩ
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature	Wechselrichter, Brems-Chopper / Inverter, Brake-Chopper	$T_{vj\ max}$			175	°C
Temperatur im Schaltbetrieb temperature under switching conditions	Wechselrichter, Brems-Chopper / Inverter, Brake-Chopper	$T_{vj\ op}$	-40		150	°C
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}	-40		125	°C
Anpresskraft für mech. Bef. pro Feder mountig force per clamp		F	40	-	80	N
Gewicht weight		G		39		g

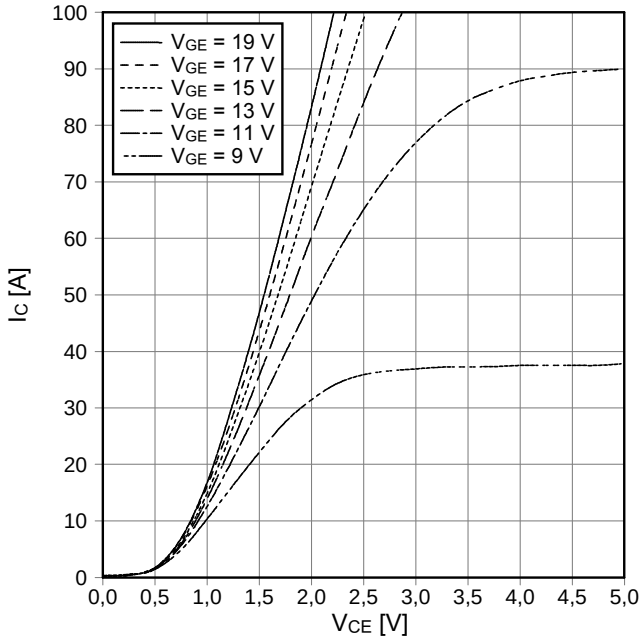
Der Strom im Dauerbetrieb ist auf 30A effektiv pro Anschlusspin begrenzt.
The current under continuous operation is limited to 30A rms per connector pin.

Vorläufige Daten
preliminary data

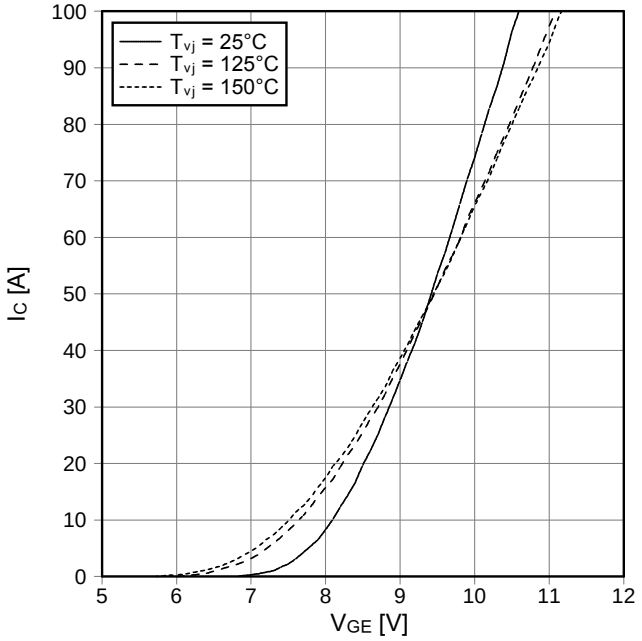
Ausgangskennlinie IGBT-Wechselr. (typisch)
output characteristic IGBT-inverter (typical)
$I_C = f(V_{CE})$
V_{GE} = 15 V



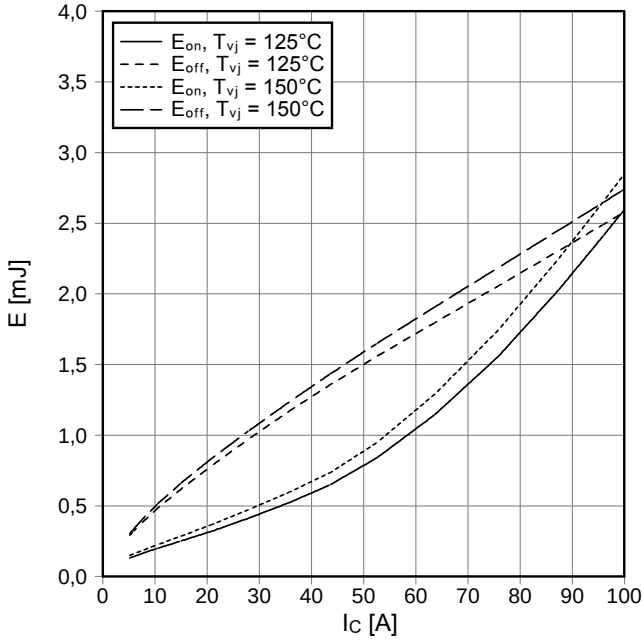
Ausgangskennlinienfeld IGBT-Wechselr. (typisch)
output characteristic IGBT-inverter (typical)
$I_C = f(V_{CE})$
T_{vj} = 150°C



Übertragungscharakteristik IGBT-Wechselr. (typisch)
transfer characteristic IGBT-inverter (typical)
$I_C = f(V_{GE})$
V_{CE} = 20 V



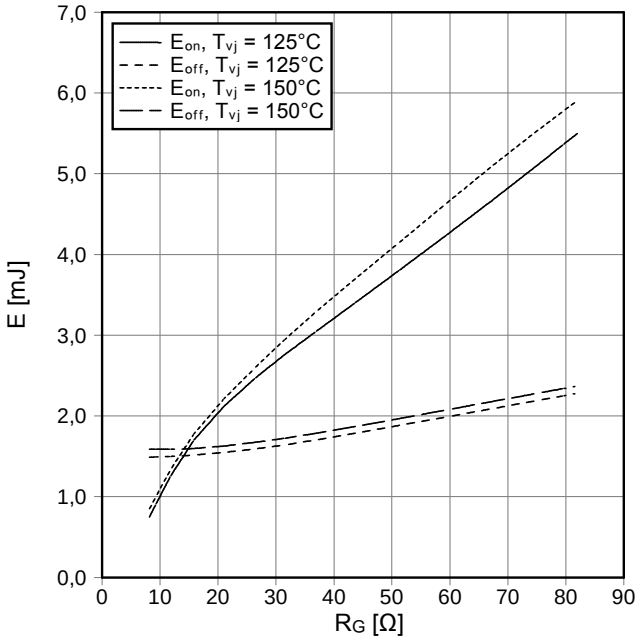
Schaltverluste IGBT-Wechselr. (typisch)
switching losses IGBT-inverter (typical)
$E_{on} = f(I_C)$, $E_{off} = f(I_C)$
V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 8.2 Ω, R_{Goff} = 8.2 Ω, V_{CE} = 300 V



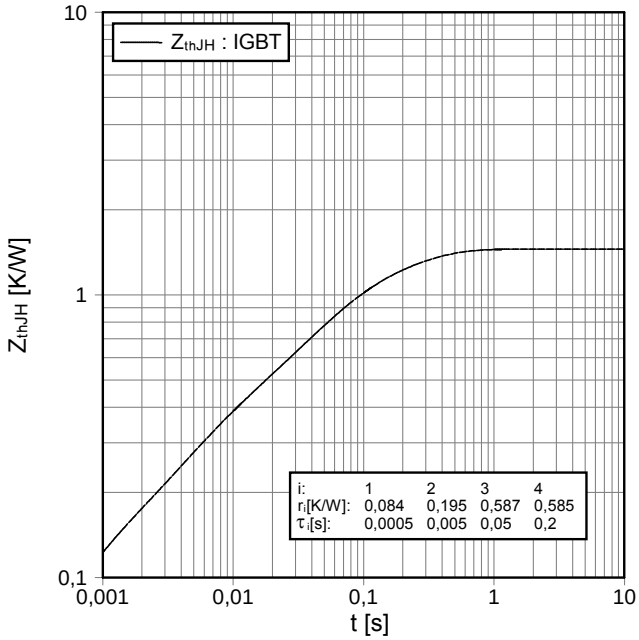
prepared by: DK	date of publication: 2009-10-19
approved by: MB	revision: 2.2

Vorläufige Daten
preliminary data

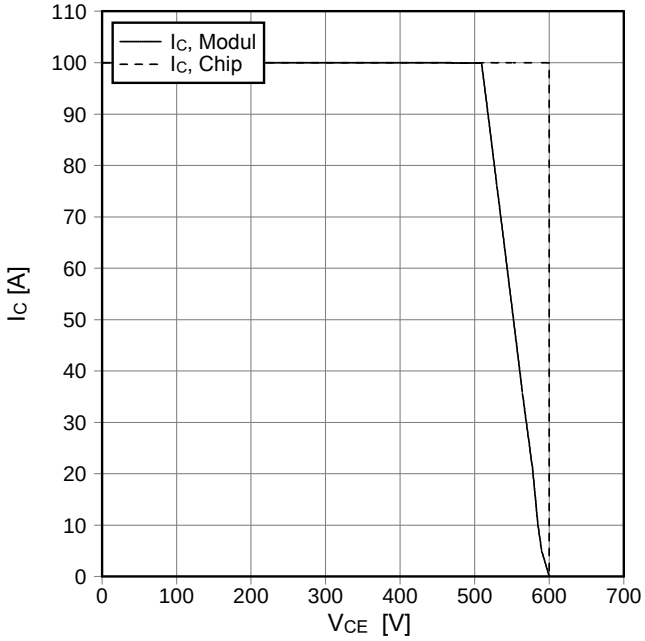
Schaltverluste IGBT-Wechselr. (typisch)
switching losses IGBT-Inverter (typical)
$E_{on} = f(R_G)$, $E_{off} = f(R_G)$
$V_{GE} = \pm 15$ V, $I_C = 50$ A, $V_{CE} = 300$ V



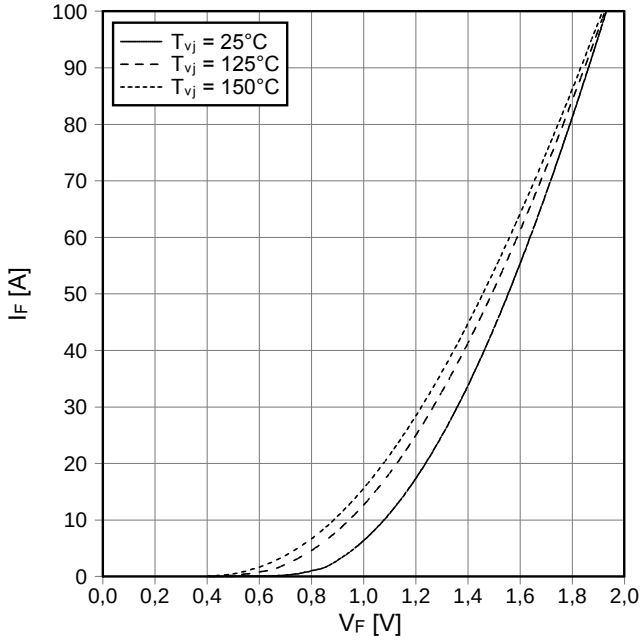
Transienter Wärmewiderstand IGBT-Wechselr.
transient thermal impedance IGBT-inverter
$Z_{thJH} = f(t)$



Sicherer Rückwärts-Arbeitsbereich IGBT-Wr. (RBSOA)
reverse bias safe operating area IGBT-inv. (RBSOA)
$I_C = f(V_{CE})$
$V_{GE} = \pm 15$ V, $R_{Goff} = 8.2\ \Omega$, $T_{vj} = 150°C$



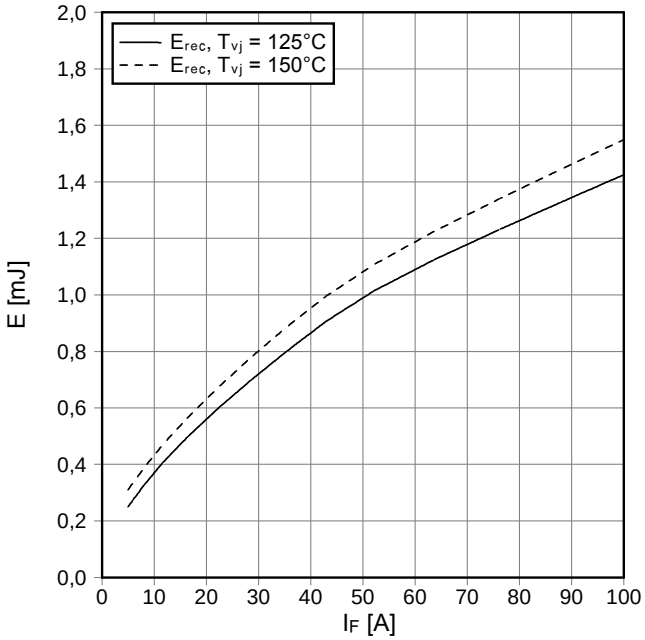
Durchlasskennlinie der Diode-Wechselr. (typisch)
forward characteristic of diode-inverter (typical)
$I_F = f(V_F)$



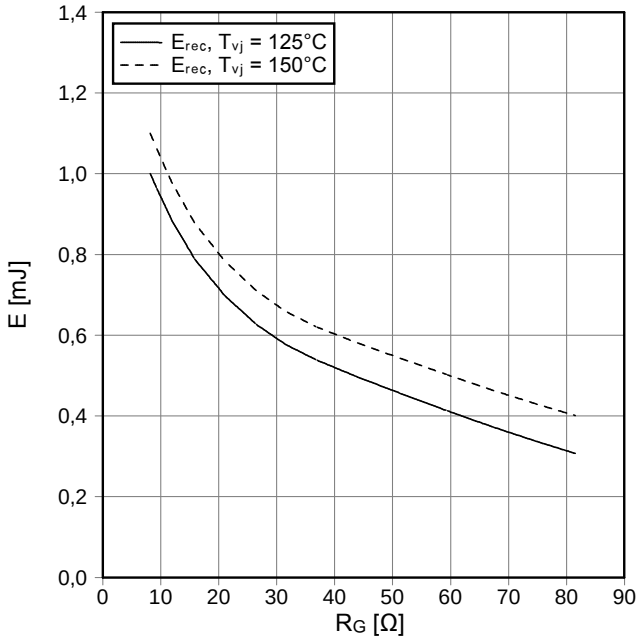
prepared by: DK	date of publication: 2009-10-19
approved by: MB	revision: 2.2

Vorläufige Daten
preliminary data

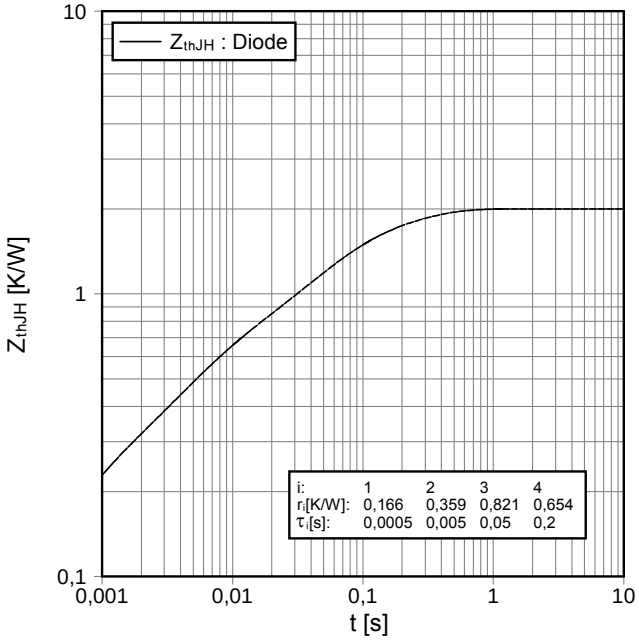
Schaltverluste Diode-Wechselr. (typisch)
switching losses diode-inverter (typical)
$E_{rec} = f(I_F)$
$R_{Gon} = 8.2\ \Omega$, $V_{CE} = 300$ V



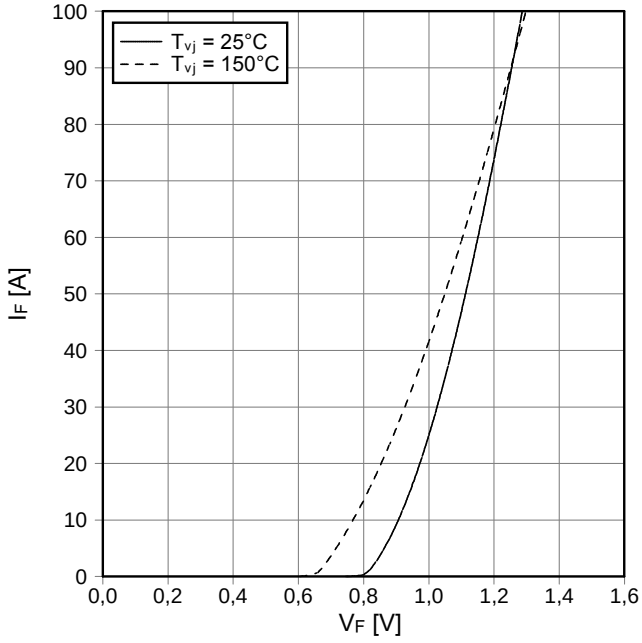
Schaltverluste Diode-Wechselr. (typisch)
switching losses diode-inverter (typical)
$E_{rec} = f(R_G)$
$I_F = 50$ A, $V_{CE} = 300$ V



Transienter Wärmewiderstand Diode-Wechselr.
transient thermal impedance diode-inverter
$Z_{thJH} = f(t)$



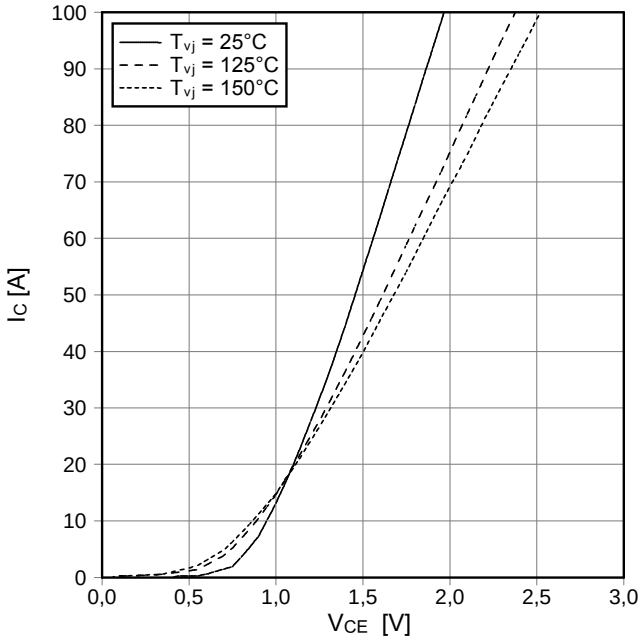
Durchlasskennlinie der Diode-Gleichrichter (typisch)
forward characteristic of diode-rectifier (typical)
$I_F = f(V_F)$



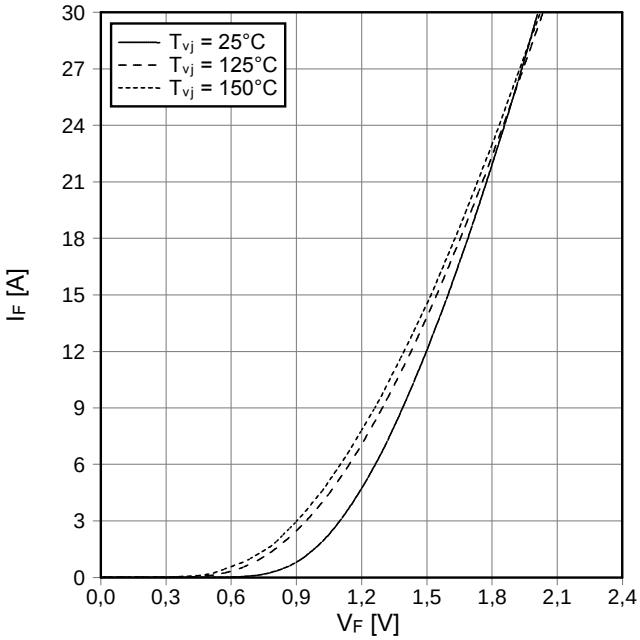
prepared by: DK	date of publication: 2009-10-19
approved by: MB	revision: 2.2

Vorläufige Daten
preliminary data

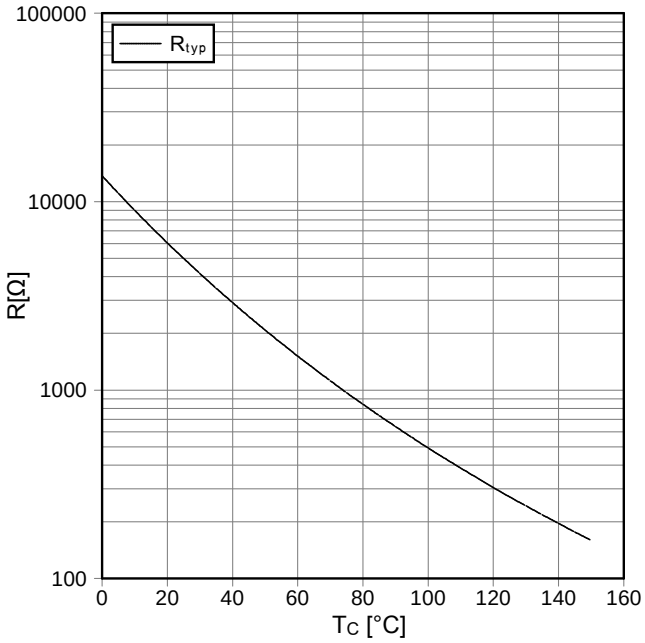
Ausgangskennlinie IGBT-Brems-Chopper (typisch)
output characteristic IGBT-brake-chopper (typical)
$I_C = f(V_{CE})$
V_{GE} = 15 V



Durchlasskennlinie der Diode-Brems-Chopper (typisch)
forward characteristic of Diode-brake-chopper (typical)
$I_F = f(V_F)$



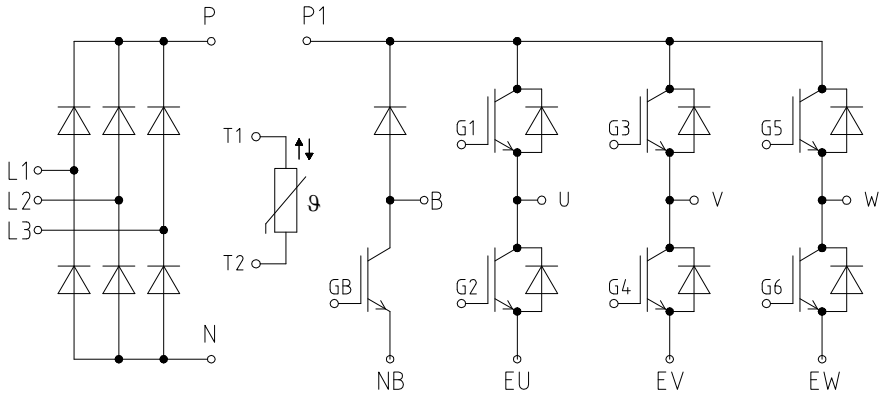
NTC-Temperaturkennlinie (typisch)
NTC-temperature characteristic (typical)
R = f (T)



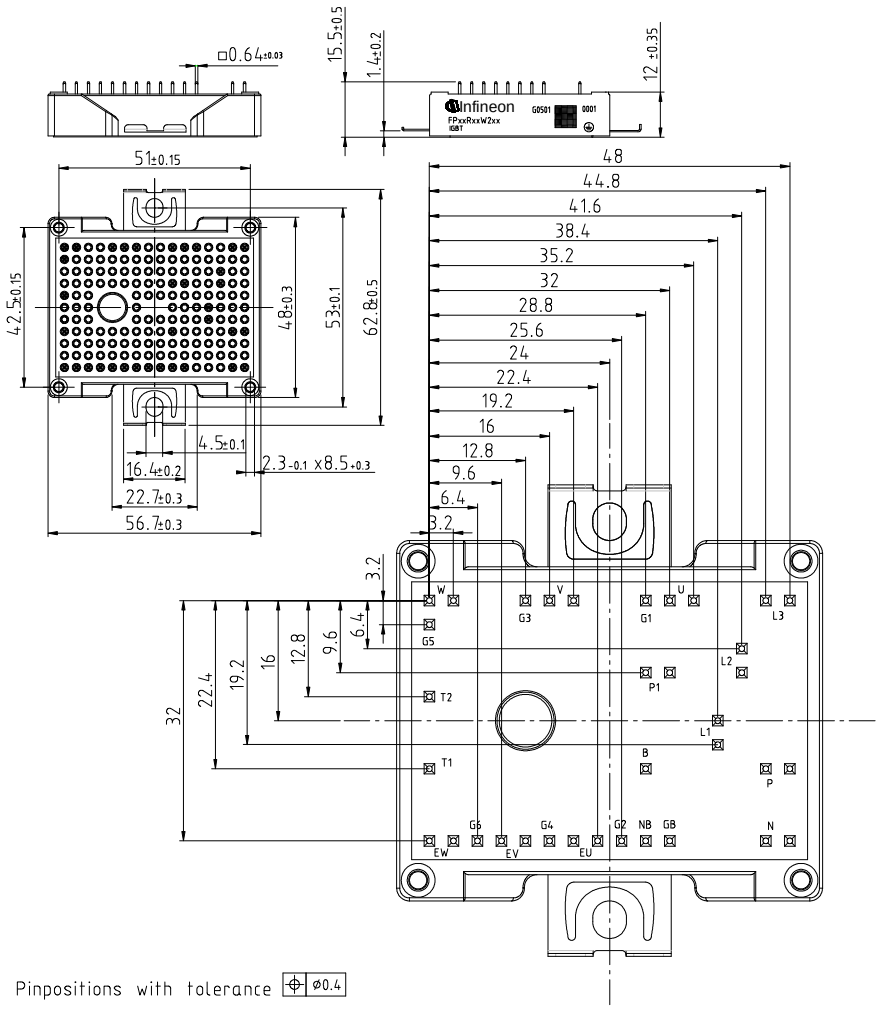
prepared by: DK	date of publication: 2009-10-19
approved by: MB	revision: 2.2

Vorläufige Daten
preliminary data

Schaltplan / circuit diagram



Gehäuseabmessungen / package outlines



prepared by: DK	date of publication: 2009-10-19
approved by: MB	revision: 2.2

Vorläufige Daten
preliminary data

Nutzungsbedingungen

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses Produktes für Ihre Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung (siehe www.infineon.com, Vertrieb&Kontakt). Für Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen der Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle
- die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

Terms & Conditions of usage

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see www.infineon.com, sales&contact). For those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or live endangering or life support applications, please notify. Please note, that for any such applications we urgently recommend
- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.

prepared by: DK	date of publication: 2009-10-19
approved by: MB	revision: 2.2

Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург, Промышленная ул, дом № 19, литера Н, помещение 100-Н Офис 331